

## 14A, 600V 超结MOS功率管

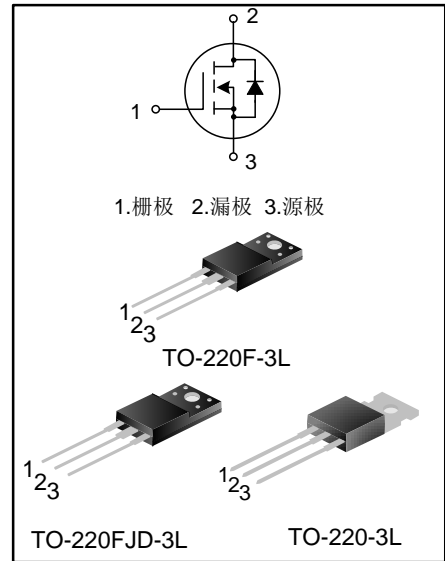
### 描述

SVSP14N60F(FJD)(T)D2 N 沟道增强型高压功率 MOSFET 采用士兰微电子超结 MOS 技术平台制造，具有很低的传导损耗和开关损耗。使得功率转换器具有高效，高功率密度，提高热行为。

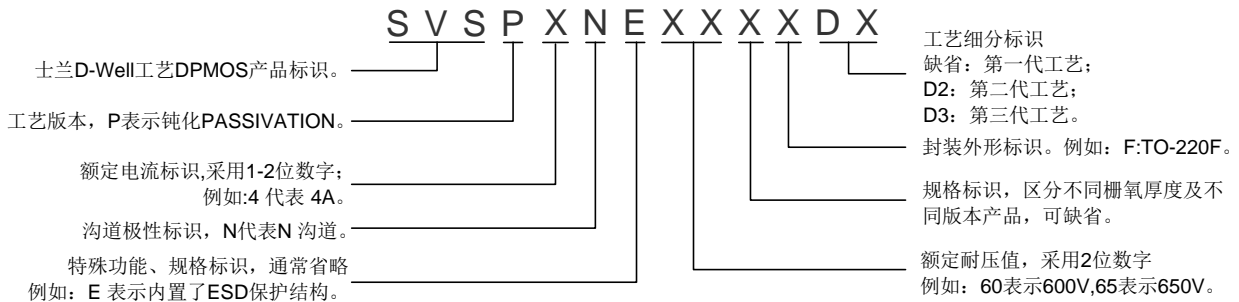
此外，SVSP14N60F(FJD)(T)D2 应用广泛。如，适用于硬/软开关拓扑。

### 特点

- ◆ 14A,600V,  $R_{DS(on)}$ (典型值)= $0.25\Omega @ V_{GS}=10V$
- ◆ 创新高压技术
- ◆ 低栅极电荷
- ◆ 定期额定雪崩
- ◆ 较强 dv/dt 能力
- ◆ 高电流峰值



### 命名规则



### 产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SVSP14N60TD2	TO-220-3L	P14N60TD2	无卤	料管
SVSP14N60FJDD2	TO-220FJD-3L	P14N60FJD	无卤	料管
SVSP14N60FD2	TO-220F-3L	P14N60FD2	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明,  $T_C=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	参数范围		单位
		SVSP14N60TD2	SVSP14N60F/FJDD2	
漏源电压	$V_{DS}$	600		V
栅源电压	$V_{GS}$	$\pm 30$		V
漏极电流	$I_D$	$T_C=25^{\circ}\text{C}$		A
		$T_C=100^{\circ}\text{C}$		
漏极脉冲电流	$I_{DM}$	56		A
耗散功率( $T_C=25^{\circ}\text{C}$ ) - 大于 $25^{\circ}\text{C}$ 每摄氏度减少	$P_D$	120	38	W
		0.96	0.3	W/ $^{\circ}\text{C}$
单脉冲雪崩能量(注 1)	$E_{AS}$	580		mJ
反向二极管 $dv/dt$ (注 2)	$dv/dt$	15		V/ns
MOS管 $dv/dt$ 耐用性(注 3)	$dv/dt$	50		V/ns
工作结温范围	$T_J$	$-55\sim+150$		$^{\circ}\text{C}$
贮存温度范围	$T_{stg}$	$-55\sim+150$		$^{\circ}\text{C}$

## 热阻特性

参数名称	符号	参数范围		单位
		SVSP14N60TD2	SVSP14N60F/FJDD2	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	1.04	3.29	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

**电气参数(除非特殊说明,  $T_C=25^\circ\text{C}$ )**

参 数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单 位	
漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V	
漏源漏电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	$\mu A$	
栅源漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	$\pm 100$	nA	
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V	
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=7.0A$	$T_J=25^\circ\text{C}$	--	0.25	0.28	$\Omega$
			$T_J=125^\circ\text{C}$	--	0.51	--	
输入电容	$C_{iss}$	$V_{DS}=100V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0\text{MHz}$	--	805	--	pF	
输出电容	$C_{oss}$		--	48	--		
反向传输电容	$C_{rss}$		--	3.2	--		
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, V_{GS}=10V, R_G=24\Omega,$ $I_D=14A$  (注 4,5)	--	14	--	ns	
开启上升时间	$t_r$		--	52	--		
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	117	--		
关断下降时间	$t_f$		--	43	--		
栅极电荷量	$Q_g$	$V_{DD}=480V, V_{GS}=10V,$ $I_D=14A$  (注 4,5)	--	26	--	nC	
栅极-源极电荷量	$Q_{gs}$		--	6.0	--		
栅极-漏极电荷量	$Q_{gd}$		--	13	--		

**源-漏二极管特性参数**

参 数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单 位
连续源极电流	$I_S$	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	11	A
源极脉冲电流	$I_{SM}$		--	--	56	
二极管压降	$V_{SD}$	$I_S=14A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	$T_{rr}$	$V_{DD}=50V, I_F=14A,$ $dI_F/dt=100A/\mu s$	--	378	--	ns
反向恢复电荷	$Q_{rr}$		--	4.6	--	$\mu C$

**注:**

- $L=79\text{mH}, I_{AS}=3.5A, V_{DD}=100V, R_G=25\Omega$ , 开始温度 $T_J=25^\circ\text{C}$ ;
- $V_{DS}=0\sim 400V, I_{SD}\leq 14A, T_J=25^\circ\text{C}$ ;
- $V_{DS}=0\sim 480V$ ;
- 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ , 占空比 $\leq 2\%$ ;
- 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图1. 输出特性

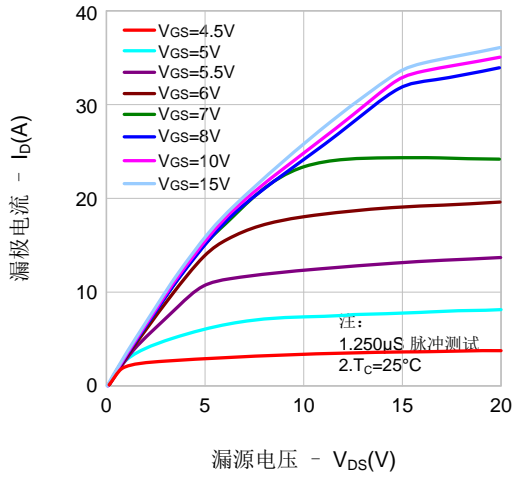


图2. 传输特性

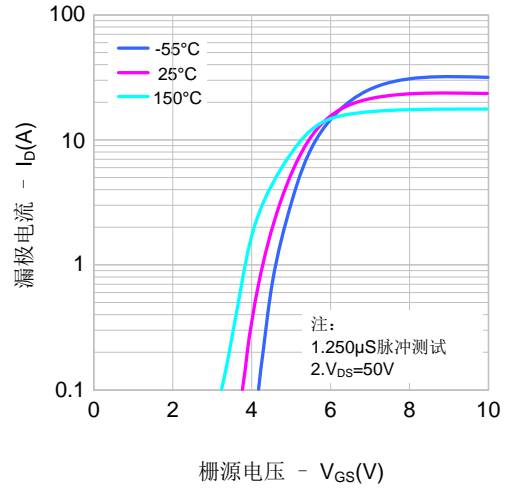


图3. 导通电阻vs.漏极电流

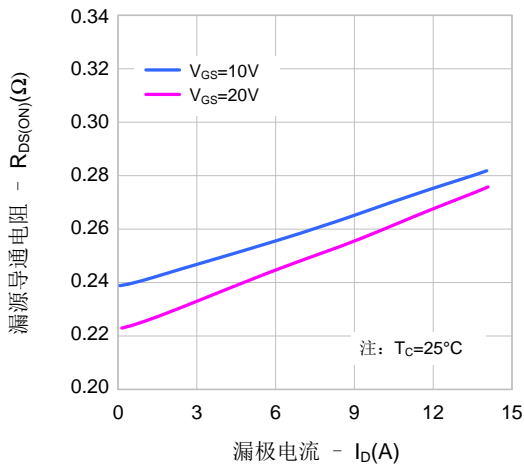


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

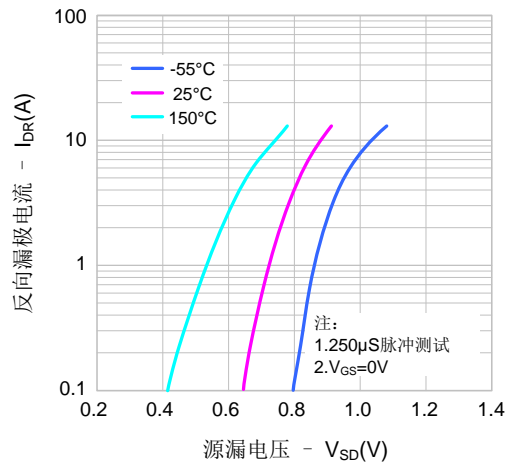


图5. 电容特性

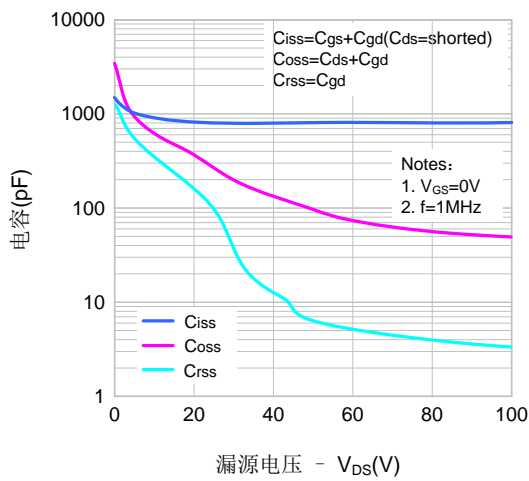
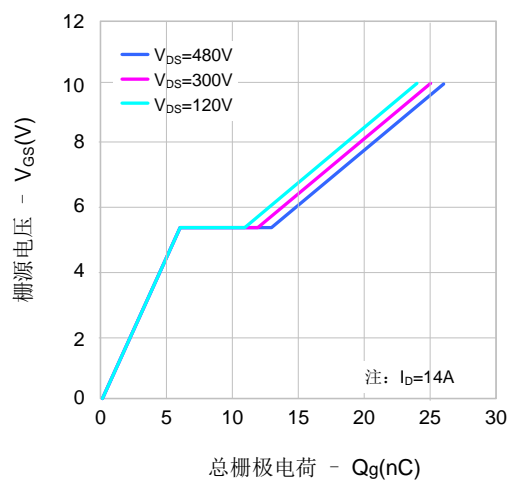


图6. 电荷量特性



典型特性曲线 (续)

图7. 击穿电压vs.温度特性

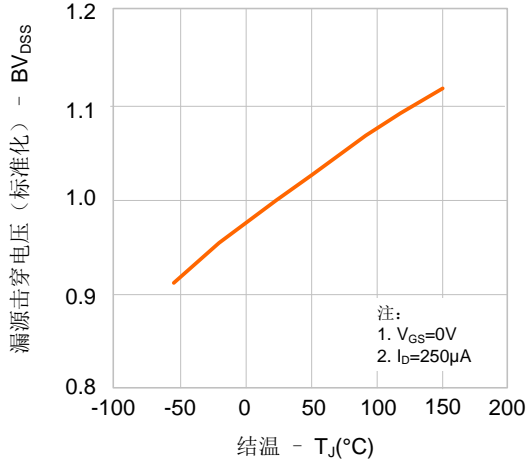


图8. 导通电阻vs.温度特性

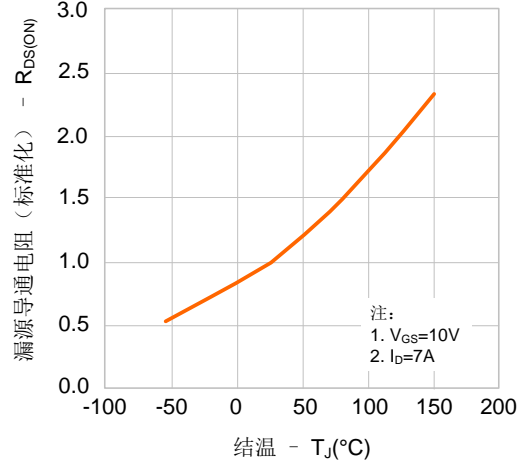


图9-1. 最大安全工作区域 (SVSP14N60TD2)

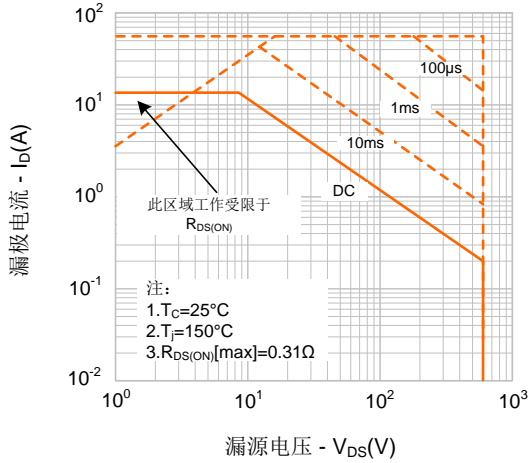
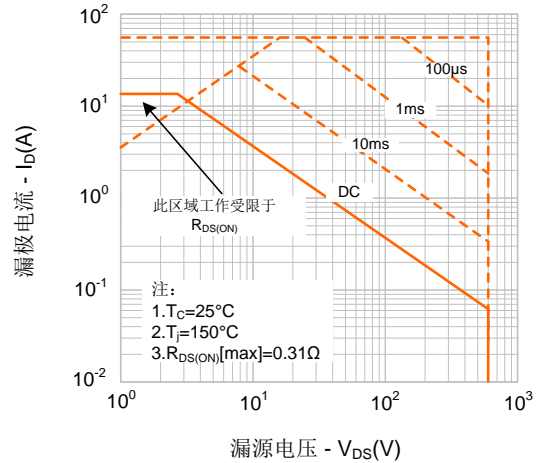


图9-2. 最大安全工作区域 (SVSP14N60F/FJDD2)



典型测试电路

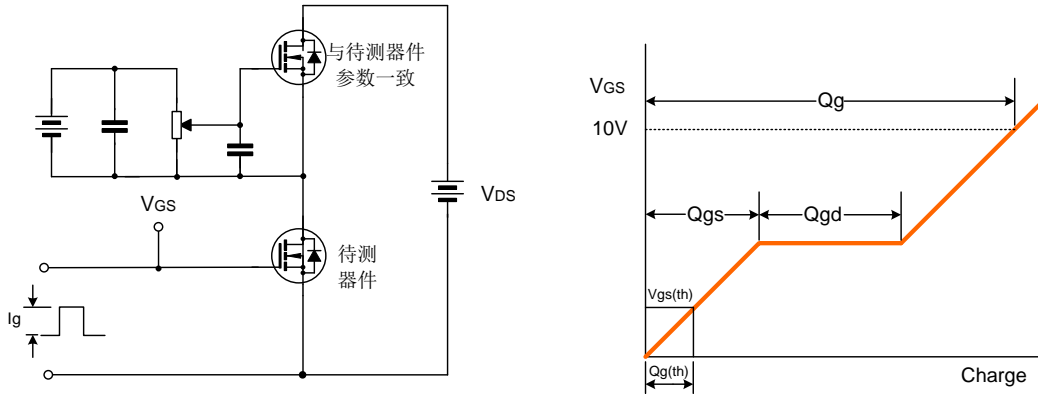


图5-1 栅极电荷量测试电路及波形图

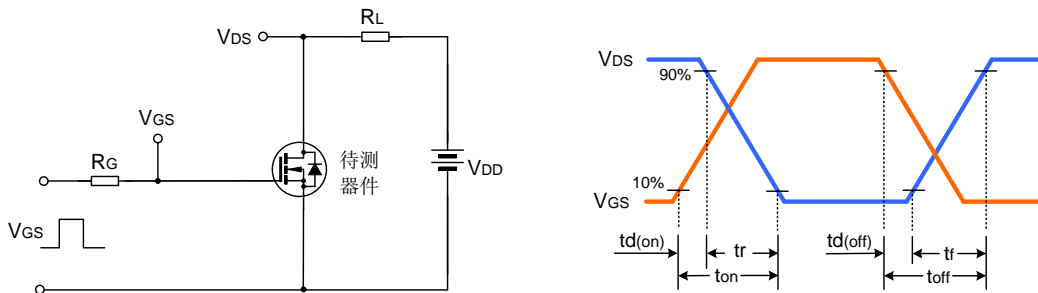


图5-2 开关时间测试电路及波形图

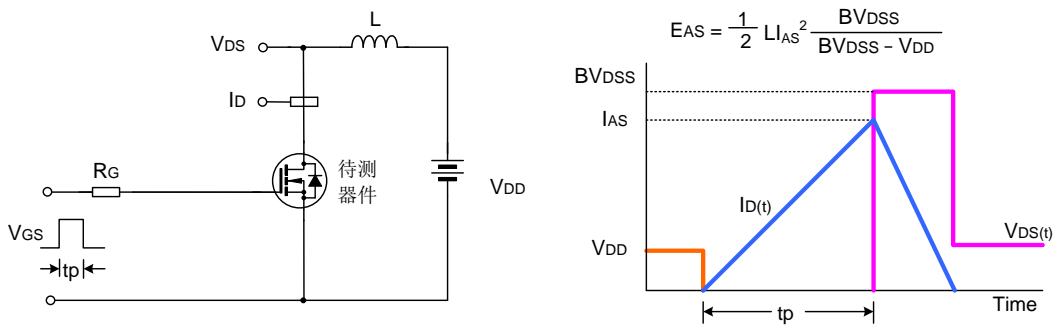
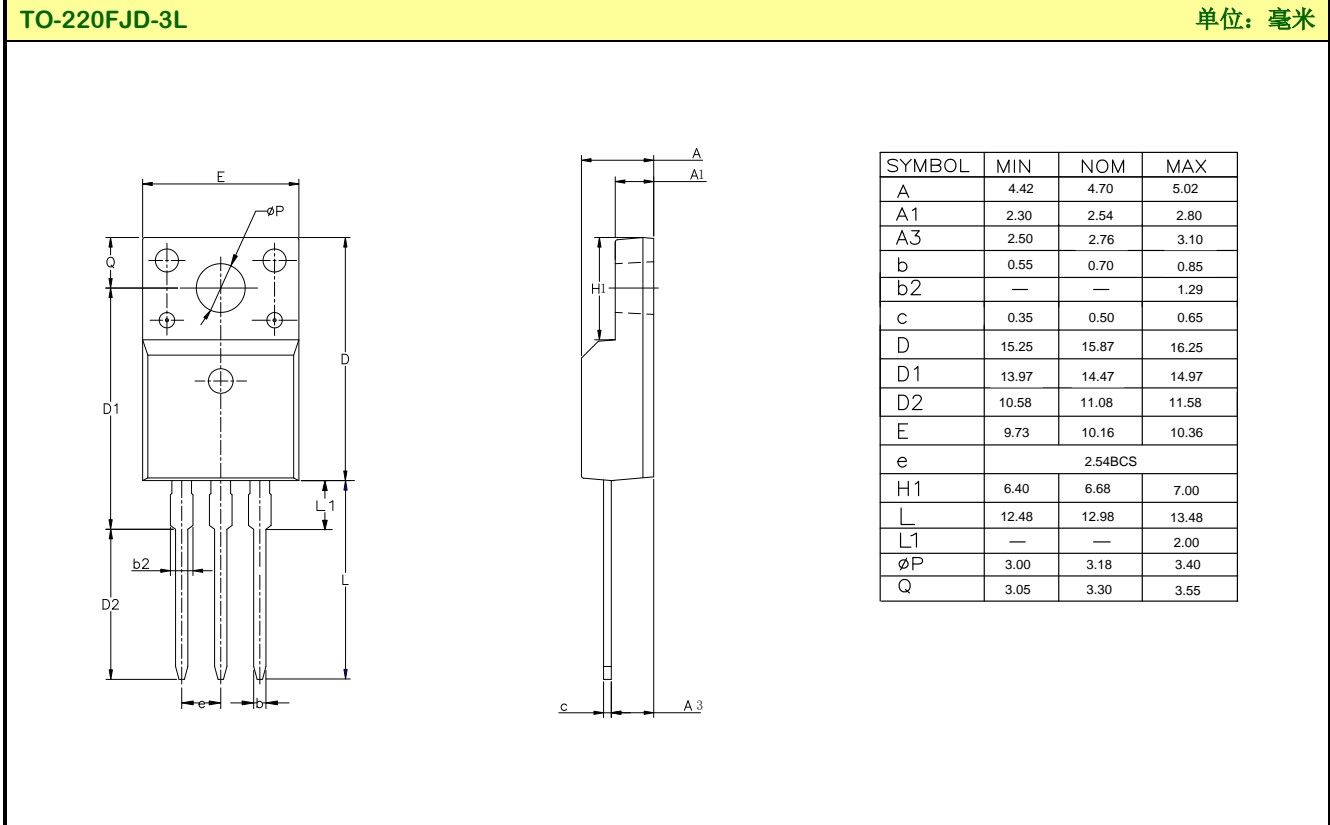
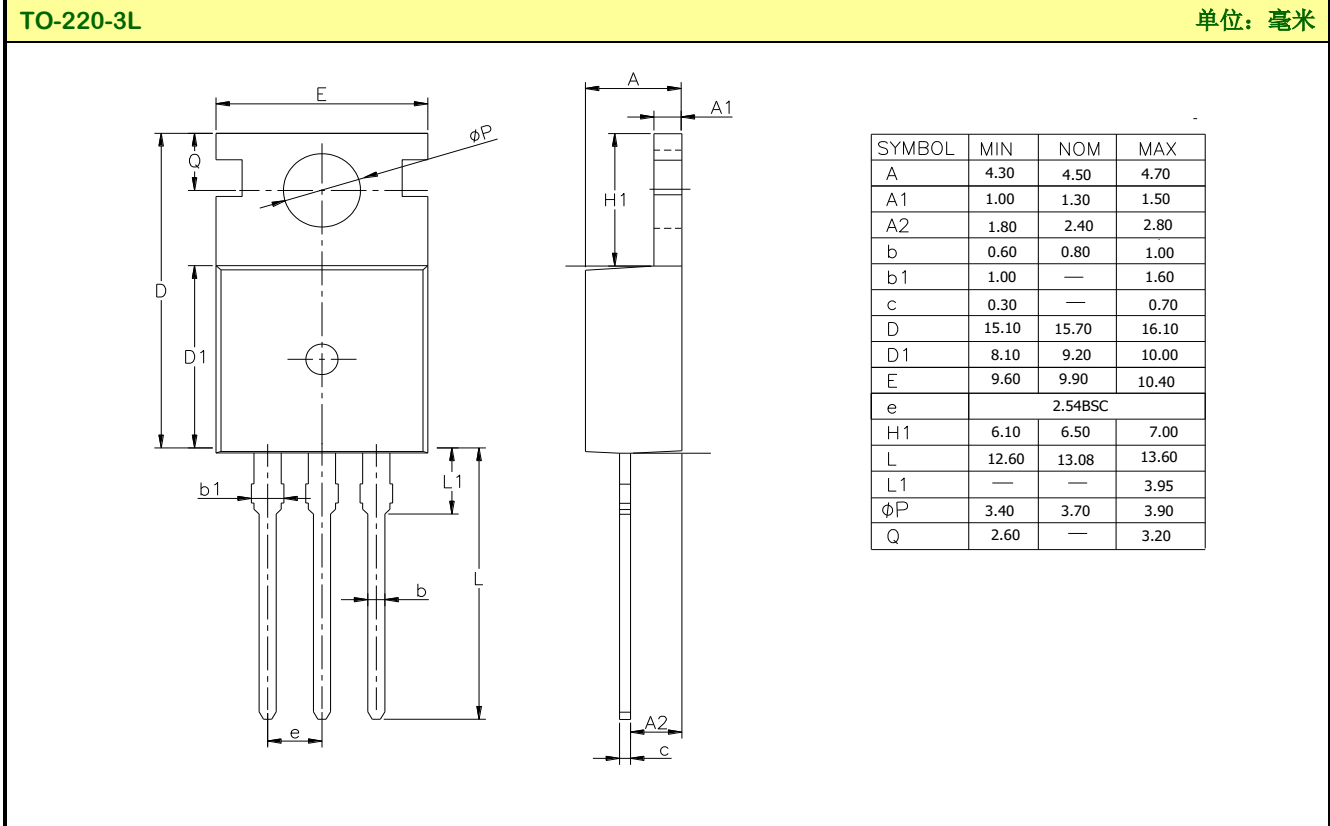


图5-3 EAS测试电路及波形图

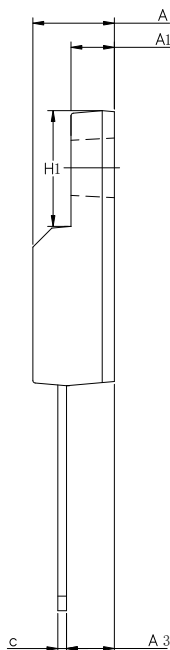
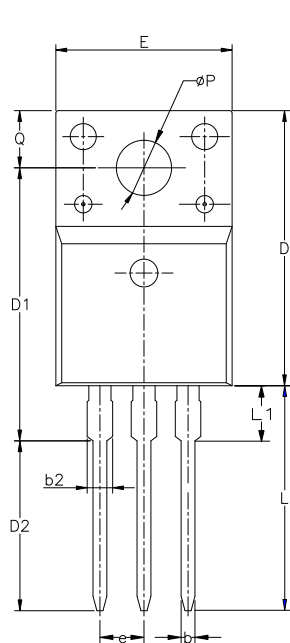
封装外形图



## 封装外形图（续）

TO-220F-3L

单位：毫米



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	/	/	3.50
$\phi P$	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

## 声明：

- ◆ 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ◆ 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



---

产品名称:	SVSP14N60F(FJD)(T)D2	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	<a href="http://www.silan.com.cn">http://www.silan.com.cn</a>

---

版 本: 1.0

修改记录:

1. 正式版本发布
-